



**Воспользовавшись трибуной шестого ежегодного мероприятия Samsung Mobile Solutions Forum, компания Samsung Electronics объявила о начале выпуска чипов памяти типа PRAM плотностью 512 Мбит. Энергонезависимая память нового поколения характеризуется высоким быстродействием и малым энергопотреблением.**

Аббревиатура PRAM расшифровывается, как phase change random access memory — память с произвольным доступом, в которой используется эффект фазового перехода

Высокая плотность хранения, большое быстродействие и малое энергопотребление открывает новой памяти дорогу в смартфоны, где такое сочетание свойств очень востребовано. По оценке Samsung, применение PRAM позволит увеличить время работы от батареи более чем на 20%.

В микросхеме PRAM плотностью 512 Мбит блок размером 64 тысячи слов можно стереть за 80 мс, что более чем на порядок превосходит показатель флэш-памяти типа NOR. При работе с сегментами данных объемом 5 МБ, память PRAM способна стирать и перезаписывать информацию примерно в семь раз быстрее, чем NOR.

Первые продукты Samsung PRAM изготавливаются по 60-нанометровой технологии, той же, которая применяется для выпуска флэш-памяти типа NOR. О цене новой памяти и объемах выпуска компания пока молчит.